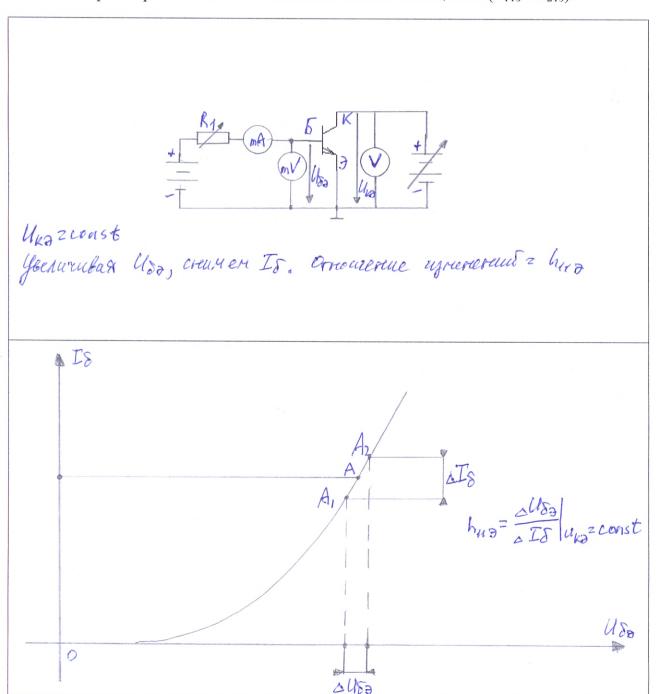
Лабораторная работа № 4 ДО

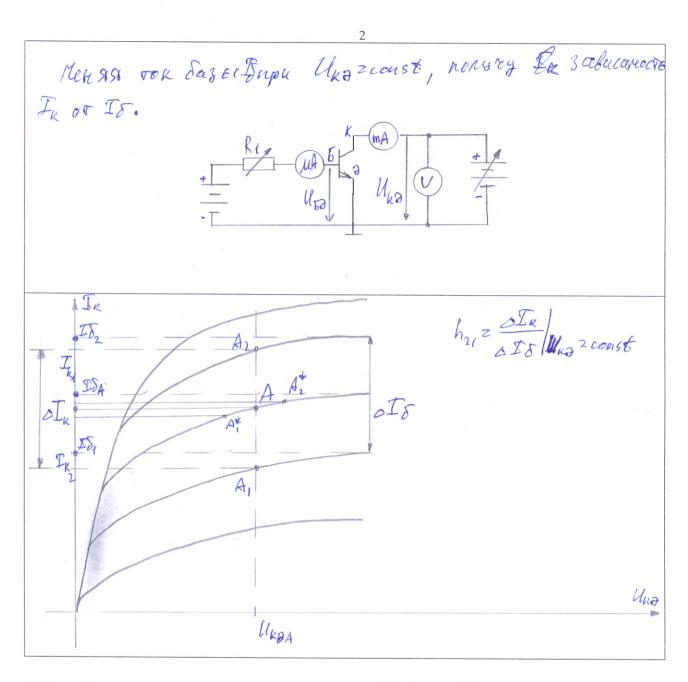
ВОЛЬТАМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА

Подготовка к работе

Перед выполнением подготовки надо изучить все материалы по данной работе. Все пункты подготовки к работе должны быть выполнены в рукописном виде.

3.2. Показать, как по вольтамперным характеристикам транзистора определить h-параметры его малосигнальной схемы замещения (h_{113} и h_{213}).



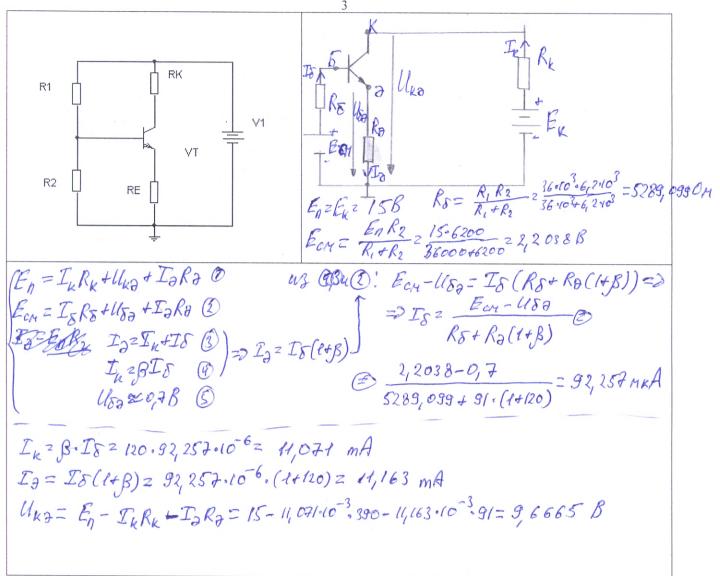


3.3. Для схемы усилительного каскада ОЭ (рис. 2) и указанных параметров элементов схемы (табл. 1) рассчитать базовый I_6 и коллекторный I_{κ} токи и напряжение коллектор-эмиттер U_{κ_9} .

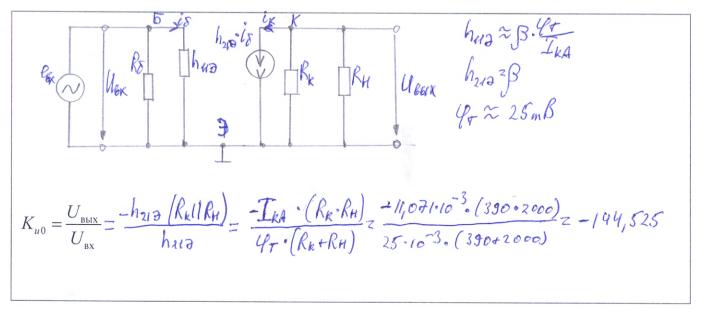
Параметры элементов каскада.

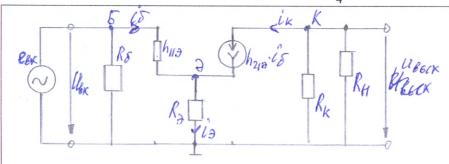
$$M = 8$$
, $N = 4$, $n = (10 \cdot M + N) \% 25 = 9 = (10 \cdot 8 + 4) \% 25 = 9$

n	Епит, В	R ₁ , кОм	R ₂ , кОм	R _K , OM	R _э , Ом	β
9	15	36	6,2	390	91	120



3.4. Нарисовать малосигнальные схемы замещения каскада для случаев и отсутствия конденсатора в цепи эмиттера. Рассчитать коэффициент усиления каскада $K_{u0} = \frac{U_{\text{вых}}}{U}$ при наличии конденсатора в цепи эмиттера и при его отсутствии (считать $R_{\Gamma} = 0$). $R_{H} = 2 \text{ кOm.}$





$$K_{u0} = \frac{U_{\text{BLIX}}}{U_{\text{BX}}} = -h_{1/2} \frac{R_{\text{K}} || R_{\text{H}}}{h_{1/2} + R_{\text{D}} (t + h_{2/2})} \frac{R_{\text{B}} || R_{\text{H}}}{R_{\text{D}}} \approx \frac{R_{\text{R}} || R_{\text{H}}}{R_{\text{D}}} = \frac{390 \cdot 2000}{91 \cdot (390 + 2000)} = 3,5869$$